

研究開発活動



当社グループの研究開発活動は、多様化するエレクトロニクス分野へ対応すべく新製品開発の強化拡大に引き続き努め、特に、次世代記録関連製品、移動体通信関連のマイクロエレクトロニクスモジュールや、素材技術と設計技術を基盤とし省エネルギーと環境に配慮したデバイスの研究開発に注力してまいりました。また、技術資源を情報家電、高速大容量ネットワーク、カーエレクトロニクスの3分野へ集中し、効率的な研究開発に取り組んでいます。

受動部品事業分野では、コア技術を活かした次世代積層セラミックチップコンデンサやインダクタ製品の開発、EMCフィルタ、複合磁性シートフレキシブルや電波暗室用電波吸収体等、EMC対策部品の製品化及び電波暗室施設の高性能化を進めました。また、高周波モジュール等のモジュール製品への対応も強化しています。

磁気応用製品事業分野では、次世代フェライト磁石の製品化、次世代高記録密度ヘッドの開発及びハイブリッドカー／電気自動車用デバイスの開発強化を進めました。

当社の開発体制は、材料・プロセス技術開発センター、デバイス開発センター、評価・解析センター、SQ研究所及び各事業部門の技術開発機能からなり、それぞれの担当領域の新製品、新技術開発を推進しています。材料・プロセス技術開発セ

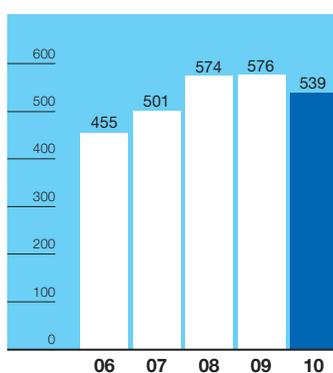
ンターは先端材料技術とプロセス技術への対応、要素技術の強化拡大を、デバイス開発センターは新規デバイス開発を、SQ研究所は次世代記録技術の研究開発を担当しています。

海外研究開発活動としては、米国、欧州の有力大学との研究開発の推進、海外研究開発子会社による現地技術資源の活用強化等が挙げられます。今後の事業基盤の確立と展開を目指す中国においても、電子部品材料関連の研究開発活動を行っています。その他連結子会社の研究開発活動としては、Headway Technologies, Inc. における次世代HDD用ヘッドの開発を引き続き推進しています。

なお、当期の研究開発費は、前期比6.4%減の539億42百万円(売上高比率6.7%)です。

研究開発費

(億円)



売上高比率

(%)

